

2011 年哈尔滨工业大学微电子考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友老苗提供

概念

- 1 空穴
- 2 陷阱效应
- 3 非简并半导体
- 4 光电导增益
- 5 状态密度
- 6 表面复合速度
- 7 布里渊区
- 8 光生电动势
- 9 准费米能级
- 10 p-n 结,

大题

- 1 画出硅锗和砷化镓的能带结构并描述。
- 2 杂质在半导体中的作用
- 3 N 型衬底的 MOS 结构表面电荷、能带随外电压变化图。

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆, 仅供参考, 纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。